



美光公司因其DRAM和NAND闪存技术创新获得知名的半导体Insight奖

Boise, Idaho, 2009年4月1日 –

美光科技股份有限公司（纽约证券交易所：MU）今日宣布，Semiconductor

Insights选择美光公司两项业内领先的DRAM和NAND创新作为其第八届Insight年度大奖的获胜者。美光公司的32Gb、34纳米的NAND闪存获得“最具创新性工艺技术”奖，其1Gb、50纳米的DDR2获得“最具创新性DRAM技术”奖。

美光公司内存事业部副总裁Brian Shirley说：“从Semiconductor

Insights这样一家知名的分析公司获得这些大奖，美光公司感到很荣幸。这些大奖证实了美光公司在DRAM和NAND闪存方面持续的技术设计和工艺创新领导力。与我们的合作伙伴一道，美光公司继续推动着内存技术的进步。”

Semiconductor Insights副总裁兼总经理Emil

Alexov说：“美光公司在DRAM和NAND领域获得了巨大的进步，两种技术的工艺水平能制造出迄今尺寸最小的产品，同时还提供首个亚40纳米的闪存设备。他们被选为两项而非一项Insight大奖的获得者，这清楚地证明了他们的创新承诺。”

据SI表示，32Gb、34纳米的芯片是业内首个密度最高的单片多层单元(MLC)

NAND闪存芯片。由于密度高、尺寸小，此芯片使客户能够轻松地增加许多消费和计算产品（例如数码相机、个人音乐播放器和固态硬盘）的NAND存储容量。32Gb、34纳米的NAND芯片由英特尔和美光公司共同开发，由双方合资成立的NAND闪存公司IM Flash Technologies制造。

1Gb、50纳米的DDR2芯片尺寸仅为41平方毫米，为客户提供目前市面上最小的DRAM核心尺寸。在分析产品之后，SI注意到本产品具有他们迄今分析过的最先进的DRAM工艺技术。50纳米、1Gb的DDR2由DRAM与南亚科技股份有限公司通过DRAM联合开发项目共同开发。

Insight大奖表彰那些通过在半导体行业的设计创新和技术进步实现巨大的技术进步并改变我们生活世界的公司。2009年3月31日，作为TechInsight在圣何塞举行的嵌入式系统大会（Embedded Systems Conference）的活动之一，在EE Times ACE奖和Insight 奖颁奖典礼上颁发了这些奖项。

关于美光公司

美光科技有限公司（Micron Technology,

Inc.）是高级半导体解决方案的全球领先供应商之一。通过全球化的运营，美光公司制造并向市场推出DRAM、NAND闪存、CMOS图像传感器、其它半导体组件以及存储器模块，用于前沿计算、消费品、网络和移动便携产品。美光公司普通股代码为MU，在纽约证券交易所（NYSE）交易。如需了解美光科技有限公司的详细信息，请访问：www.micron.com。

Micron（美光）和美光环绕标志是美光科技有限公司（Micron Technology, Inc.）的商标。所有其他商标属其各自所有人财产。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

CONTACT:

Kirstin Bordner
Micron Technology, Inc.
208-368-5487
kbordner@micron.com